

第21回プロセスエンジニア向けの分析基礎セミナー(B-1)

時 間	プ ロ グ ラ ム	講 師
10:00-10:15	1. はじめに	新宮 一恵
10:15-11:00	2. 形態観察及び微小領域分析ー(1) SPM, SEM, EDS, EBSD, CL	齋藤 進
11:00-11:50	3. 形態観察及び微小領域分析ー(2) FIB, TEM/STEM	高橋 和照
11:50-12:10	4. 表面の組成分析 XPS, AES	坂本 文孝
質疑応答		
12:10-12:55	**ランチ休憩** 	
12:55-13:15	5. 表面の有機汚染分析 TOF-SIMS, Raman, FT-IR	新宮 一恵
13:15-13:45	6. 表面の金属汚染分析 VPD, TXRF, Surface-SIMS, TOF-SIMS	山田 正隆
13:45-14:20	7. 薄膜組成分析ー(1) Accelerator (RBS,HFS,PIXE,NRA)	永山 進
14:20-14:55	8. 薄膜組成分析ー(2) XRD, XRR, XRF	高橋 和照
質疑応答		
14:55-15:10	**アフターヌーンブレイク** 	
15:10-15:50	9. 不純物深さ方向濃度分析 SIMS	大淵 真澄
15:50-16:20	10. 不純物バルク分析 GDMS, LA-ICPMS, ICP-OES, IGA	坂本 文孝
16:20-16:35	11. 半導体パッケージ内部ガス分析 IVA,HR-IVA(RGA)	山田 正隆
16:35-16:45	12. まとめ (適切な分析手法の選択)	永山 進
質疑応答		

本プログラムの中には質疑応答の時間もございます。
ご不明な点などございましたら、なんなりとご質問ください。

